

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年3月6日(06.03.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/047482 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/673 (2006.01) H01L 21/683 (2006.01)
H01L 21/31 (2006.01) H01L 21/3065 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/029275

(22) 国際出願日: 2024年8月19日(19.08.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-142542 2023年9月1日(01.09.2023) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 長山 将之(NAGAYAMA, Nobuyuki); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノ

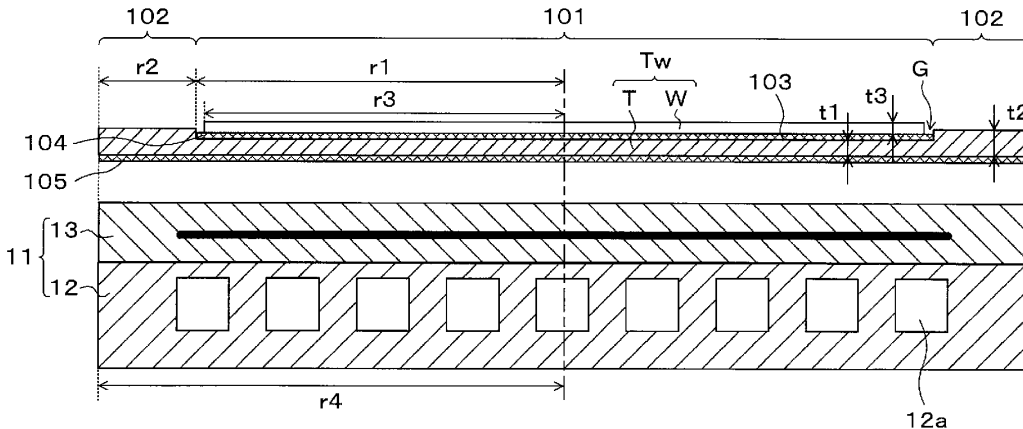
ヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).

(74) 代理人: 金本 哲男, 外(KANEMOTO, Tetsuo et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町1-20 角張ビル 曙国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE AND SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM

(54) 発明の名称: 基板処理装置及び基板処理システム



(57) Abstract: This substrate processing device for processing a substrate comprises: a processing chamber; and a support member which is placed inside the processing chamber and has, on the upper surface, a tray support surface for supporting a tray. On the upper surface of the tray, a recess part which accommodates the substrate with a first heat conductive material therebetween is formed. The tray support surface is configured so that a second heat conductive material is interposed between the lower surface side of the tray and the tray support surface.

[続葉有]

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 基板を処理する基板処理装置であって、処理チャンバと、前記処理チャンバ内に配置され、上面にトレイを支持するトレイ支持面を有する支持部材と、を備え、前記トレイは、その上面に第1の伝熱材料を介して前記基板を収容する凹部が形成され、前記トレイ支持面は、前記トレイの下面側との間に第2の伝熱材料が介在するように構成される。